解析OP77。 持沙汉外活用

増幅回路設計の真髄を検証する



解析OPTU。 持沙洛門

増幅回路設計の真髄を検証する

黒田 徹 著

CQ出版社

まえがき

筆者が初めてOPアンプを手にしたのは30年ほど前のことで、モノリシックICのOPアンプは μ A709など、わずか数種類でした。翻って現在は、選択を迷うほど多くの型名のOPアンプICがあります。そしてOPアンプに関する名著も枚挙に事欠きません。ただ、これらの書物はOPアンプの使い方や応用回路の紹介を重視するものがほとんどです。

私はそれらの書物から貴重な情報を得ましたが、若干のモノ足りなさも抱いておりました。その訳は「OPアンプのデータシートに、その型名固有の欠点が積極的に記されることはない。それゆえ隠れた欠点をあぶり出すには、OPアンプの内部回路を解析するしかない」ということを常日頃、肌身に感じていたからです。

そこで私は十数年間、めぼしいOPアンプの内部回路の解析に没頭しました。そして、 内部回路の解析は次のメリットをもたらしました。

- ・データ・シートを深く読む力がつく
- ・基本的なアナログ回路の設計法を習得できる
- ・OPアンプの間違った使い方を避けることができる
- ・OPアンプ固有の潜在能力を目一杯引き出すことができる
- ・回路の美しさを感じる心を養い、回路設計の意欲を高める

本書はこの考えに基づき、次のシナリオでOPアンプの内部回路を解析します。

第1章:個別のトランジスタ5石で簡単なOPアンプを作り、基本的な特性を測定しながら、OPアンプの用語と動作を学びます。

第2章:代表的な汎用OPアンプIC 4558の内部回路を解析し,第1章の5石OPアンプと 比較します。

第3章:回路シミュレータSPICEを使い,第1章の5石OPアンプを改良して特性を飛躍的に高めます(トランジスタ技術2001年11月号,特設記事を補筆)

第4章:市販のOPアンプICでは実現困難な高性能アンプを、個別トランジスタ回路で製作します。また、トランジスタの寄生容量に起因する非直線ひずみを計算し、独自の回路でひずみをキャンセルします。

第5章: Bi-FET型OPアンプと5532型OPアンプを解析し、ウィルソン型カレント・ミラーなどの動作を学びます。



4 まえがき

第6章:定番・高精度 OPアンプと低雑音 OPアンプ AD797 を解析し、高度の回路テクニックを学びます。

第7章:高速·広帯域型OPアンプの解析と応用例。

第8章:5 V以下の低電圧単一電源で動作する高性能 CMOS型 OP アンプの紹介(トランジスタ技術 2001年3月号特集記事および追加の応用回路).

なお予備知識として、必要な最小限のトランジスタ物理を Appendix にまとめました。

本書が、アナログ回路の設計を目指す学生諸氏、OPアンプの応用回路を設計するエンジニア諸兄、また趣味でアンプを自作する諸兄のお役に立てれば幸いです。

最後になりましたが、本書の執筆に暖かい励ましを戴いた遠坂俊昭氏、出版の機会を与えてくださったCQ出版株式会社、企画・編集を賜わった蒲生良治氏に深くお礼申し上げます。

2002年8月 黒田 徹

------謝辞-------

本書の第4章~第7章は、(株)アイエー出版発行の「ラジオ技術」誌に連載しました「実験トランジスタアンプ設計講座・実用技術編」の記事を使用しております。記事使用の許可を戴いたアイエー出版社ならびに十数年に及ぶ編集を賜った堀井資朗氏に深く感謝申し上げます。

目 次

第 1	章 OP アンプを手作りトランジスタ回路で学ぶ	11
1.1	OP アンプのあらまし	11
	OPアンプのもつ基本端子は五つ	11
	二つの入力端子と一つの出力端子	12
	OPアンプの増幅度…差動電圧利得 <i>A_{VD}</i>	12
	OPアンプの電源電圧 ···································	12
	設計するときに便利な理想OPアンプの考え	13
1.2	5石 OP アンプの実験	13
	OPアンプの中身…トランジスタによる増幅回路	13
	5石 OP アンプを製作する	14
	5石OPアンプの回路動作 ····································	16
	非反転増幅器としての実験	18
	ボルテージ・フォロワ回路の実験	21
	反転増幅器の実験	22
1.3	OP アンプの交流(AC)特性	23
	最大出力電圧振幅対周波数特性	23
	スルーレート(Slew Rate)	24
	その他の交流特性	25
1.4	OP アンプの直流(DC)特性 ····································	25
	入力バイアス電流 I_B とオフセット電流 I_{IO}	25
	入力オフセット電圧 V_{IO}	26
	最大出力電圧対負荷抵抗特性	28
	同相入力電圧範囲	28
1.5	OPアンプを負帰還で使うときの安定性	28
	増幅器と発振回路は表裏一体	28
	利得は複素数で表す	
	周波数特性を表すボーデ線図	30
	オープン・ループ・ゲインのボーデ線図	30
	ボーデの安定判別法	31
	〈コラム〉アナログIC設計に関する参考文献紹介	34

第2	章 汎用 OP アンプ IC 4558 の解析	35
2.1	4558 の基本回路解析 オリジナル型名はRC4558・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35 36 38 39 40 43 44 46
ح .ح	4008 の寺価凹路と電気的特性 トランジスタの小信号等価回路 hパラメータの一部を省略した小信号等価回路 カレント・ミラー負荷・差動増幅回路の小信号等価回路 エミッタ・フォロワの小信号等価回路 RC4558のオープン・ループ・ゲイン対周波数特性 スルーレートと位相補償容量の関係 スルーレートと利得帯域幅の関係 4558の雑音・ひずみ率特性 4558のDC特性	48 49 50 51 55 56 56
第3	章 回路シミュレータでつくる本格 OP アンプ	61
3.1	アナログ回路シミュレーションには SPICE なぜ回路シミュレータか SPICEとは SPICEの回路ファイル サデル・パラメータも必須 SPICEによるシミュレーションの種類 5石 OP アンプのシミュレーション	61 61 63 63 63
3.2	5石 OP アンプを改良する 最大出力電流を増やすための改良 オープン・ループ・ゲインを増やすための改良 入力オフセット電圧を最小化する	···· 69 ····· 70

	入力オフセット電圧が増加した理由	
	入力オフセット電圧を減らす簡単な方法	77
	カレント・ミラー回路とダーリントン回路で入力オフセット電圧を減らす …	
	初段トランジスタの選別が重要	
	飽和防止回路 ·····	
	10石非反転増幅器の周波数特性	
	電源電圧除去比(Supply Voltage Rejection Ratio)の解析	
	10石OPアンプのスルーレート	91
Appe	endix 1 SPICEモデルを理解するために――	
	トランジスタの等価回路	
	エバース・モル・モデル	92
	▶ 活性領域 ▶ 逆接続領域(逆方向活性状態ともいう)▶ 飽和領域(飽和状	
	態ともいう)	
	周波数特性の計算に役立つハイブリッドπ型モデル	95
	▶ ベース-実効ベース間コンダクタンス g_x ▶ 相互コンダクタンス g_m ▶ 実効	
	ベース-エミッタ間コンダクタンスgπ▶ アーリ電圧▶ 接合容量▶ 遷移時	
	間と拡散容量 $lackbrack f_T$ と $ au_F$ の関係	
	〈コラム〉順方向遷移時間 T _F を測定する	·· 104
Appe	endix 2 周波数特性改善のために ベース接地回路のおさらい…	105
	 ▶ ベース接地回路の特徴 ▶ ベース接地回路の出力静特性 ▶ ベース接地回路の入力抵抗 ▶ ベース接地回路の入力抵抗 ▶ ベース接地回路の電圧利得 ▶ ベース接地増幅回路の電圧利得 ▶ ベース接地増幅回路の高域・周波数特性 ▶ 電流源でドライブされたベース接地回路 	
第4	章 トランジスタによる IC を越える OP アンプの設計	111
4.1	なぜ個別半導体アンプか	111
	OPアンプICのもつ弱点	. 111
	個別半導体…トランジスタによる OP アンプ回路	. 112
4.2	トランジスタによる OP アンプ回路のあらまし	112
	設計する OP アンプ回路の骨格	
	フォールデッド・カスコード回路を採用する	
4.3	初段 FET 差動回路を設計するために	
	接合型 FET の基本特性	. 115
	カスコード回路の電圧利得と周波数特性	
	初段 FET の選択 ···································	. 118

	2段目トランジスタTr ₁ ・Tr ₂ と出力段Tr ₅ ・Tr ₆ ····································	119
4.4		
	初段をカスコード・ブートストラップにする	
	2段目出力電圧のひずみ率を計算する	
	<i>C</i> _{ob} キャンセル回路でひずみ率を激減させる	127
	2段目の実際の回路設計	
	出力段トランジスタの C_{ob} をキャンセルする	
	AB 級コンプリメンタリ C_{ob} キャンセル回路 \cdots	
	A級コンプリメンタリ Cobキャンセル回路 ·······	
4.5		
	位相補償容量の最適値を求める	
	スルーレートを確認する	
	製作に使用する部品	
	電気的特性の測定	
App	endix 3 C_{ob} の電圧依存性によるひずみを解析的に計算す	る 144
第5	章 汎用 OP アンプ IC の解析	147
	汎用OPアンプとは ·······	147
5.1	Bi-FET型OPアンプTLO7xシリーズの解析	
	Bi-FETプロセス ·······	
	2種類のカレント・ミラー	
	TL07xとTL08xの雑音特性 ·······	
5.2		
·-	ワイドラー型カレント・ミラーとウィルソン型カレント・ミラー・	
	LF353の初段・共通ソース電流	
	スルーレートの算出	
	出力電流の制限回路	
	出力インピーダンス対周波数特性	
	Q ₅ の飽和防止回路 ····································	
	ひずみ率特性と周波数特性	
5.3	バイポーラ OP アンプ NE5532 の解析	
	入力端子間ダイオードの役割	
	カレント・ミラーと飽和防止回路	
	ラテラル (Lateral) PNP トランジスタ	
	フィード・フォワード(位相)補償	
	非対称 AB級動作の出力段	

第6	章 高精度および低雑音 OP アンプ IC の解析	169
6.1	高精度 OP アンプの構成と OP07 ······	169
	高精度OPアンプとは	169
	入力バイアス電流打ち消し回路	170
	入力オフセット電圧を小さくする工夫	172
	OP07のAC特性と雑音特性 ······	173
	高精度 OP アンプを DC サーボ回路に使う	174
6.2	低雑音 OP アンプと雑音解析の基礎	176
	雑音波の大きさは二乗平均値で表す	176
	〈コラム〉アンサンブル平均とは	176
	抵抗で発生する熱雑音	177
	理想バイポーラ・トランジスタのショット雑音	178
	理想バイポーラ・トランジスタの雑音等価回路	178
	差動増幅回路の雑音等価回路	179
	OPアンプの雑音等価回路	
	OPアンプの入力換算雑音電圧密度	
	OPアンプの入力雑音電流密度	
	信号源抵抗の影響	
	OPアンプの全入力雑音電圧密度	
	帰還率の逆数…ノイズ・ゲイン	
6.3	低雑音 OP アンプ AD797 の構成 ······	
	AD797のオープン・ループ・ゲイン	
	AD797の位相補償容量	
	出力段のひずみ打ち消し回路	190
第7	章 高速・広帯域 OP アンプ IC の解析	193
7.1	普通の高速・広帯域 OP アンプ	193
	高速・広帯域 OP アンプには二つのタイプがある	
	高速PNPトランジスタを作るVIPプロセスのLM6361シリーズ	193
	LM6361/6364は局部電流帰還で安定化	195
	〈コラム〉局部電流帰還について	196
	オープン・ループ・ゲインを確認すると	197
	大きな負荷容量でも発振しない仕組み	
	LM6361 シリーズのその他の特性 ······	
	LM6361 シリーズ上位…CBプロセスによる AD847 シリーズ	198

	ダーリントン出力段でも容量負荷に強い仕組み	99
	JFETソース・フォロワ入力のOPA655…DGとDPが小さい 2	200
7.2	カットオフ周波数が変化しない電流帰還型 OP アンプ 20	1 (
	普通のOPアンプ…電圧帰還型OPアンプの欠点 2	201
	電流帰還型 OPアンプの動作原理 2	203
	トランス・インピーダンス(Trans-impedance)の概念を使うと 2	205
	反転増幅器で使うときのクローズド・ループ・ゲイン ······ 2	207
	電流帰還型 OP アンプの出力インピーダンスはどうなるか 2	208
	スルーレートを制約するもの	209
	許容差動入力電圧は低いので要注意	210
	広帯域 AC-DC コンバータへの応用 ······ 2	210
7.3	JFET 入力・高速広帯域 OP アンプ ······ 21	2
	CBプロセスによる AD845 ······ 2	212
	Difet プロセスによる OPA627/637 2	212
	高速性を示す重要パラメータ…セトリング時間 2	215
	広帯域・平衡増幅器へのOPA627の応用 ······ 2	216
	平衡増幅器における同相信号除去比とは	217
	CMRR を改善する同相負帰還技術	218
	CMIC EXT 1 OF THE PROPERTY OF	
第8	章 CMOS型OPアンプICの解析 22	
•	章 CMOS型OPアンプICの解析 22	20
第8 8.1	章 CMOS型OPアンプICの解析 22 CMOS OPアンプの登場と高性能化	20
•	章 CMOS型OPアンプICの解析 22 CMOS OPアンプの登場と高性能化 22 低消費電力化とレール・ツー・レール動作 22	20 220
•	章 CMOS型OPアンプICの解析22CMOS OPアンプの登場と高性能化28低消費電力化とレール・ツー・レール動作2CMOSレール・ツー・レールOPアンプAD85322	20 220 221
•	章 CMOS型OPアンプICの解析22CMOS OPアンプの登場と高性能化22低消費電力化とレール・ツー・レール動作2CMOSレール・ツー・レールOPアンプAD85322低ひずみのOPアンプOPA340/350/2340/23502	2O 220 221 223
•	章 CMOS型OPアンプICの解析22CMOS OPアンプの登場と高性能化22低消費電力化とレール・ツー・レール動作2CMOS レール・ツー・レールOPアンプAD85322低ひずみのOPアンプOPA340/350/2340/23502R-R入力特有のミッド・スイングひずみに注意2	20 220 221 223 224
•	章 CMOS型OPアンプICの解析22CMOS OPアンプの登場と高性能化28低消費電力化とレール・ツー・レール動作2CMOSレール・ツー・レールOPアンプAD85322低ひずみのOPアンプOPA340/350/2340/23502R-R入力特有のミッド・スイングひずみに注意2ミッド・スイングひずみを避ける方法2	20 220 221 223 224 226
8.1	章 CMOS型OPアンプICの解析22CMOS OPアンプの登場と高性能化28低消費電力化とレール・ツー・レール動作2CMOSレール・ツー・レールOPアンプAD85322低ひずみのOPアンプOPA340/350/2340/23502R-R入力特有のミッド・スイングひずみに注意2ミッド・スイングひずみを避ける方法2CMOSの低雑音 OPアンプLMV7512	20 220 221 223 224 226 228
•	章 CMOS型OPアンプICの解析22CMOS OPアンプの登場と高性能化22低消費電力化とレール・ツー・レール動作2CMOS レール・ツー・レールOPアンプAD85322低ひずみのOPアンプOPA340/350/2340/23502R-R入力特有のミッド・スイングひずみに注意2ミッド・スイングひずみを避ける方法2CMOSの低雑音OPアンプLMV7512さらに発展する CMOS OPアンプたち2	20 220 221 223 224 226 228 29
8.1	章 CMOS型OPアンプICの解析22CMOS OPアンプの登場と高性能化22低消費電力化とレール・ツー・レール動作2CMOSレール・ツー・レールOPアンプAD85322低ひずみのOPアンプOPA340/350/2340/23502R-R 入力特有のミッド・スイングひずみに注意2ミッド・スイングひずみを避ける方法2CMOSの低雑音 OPアンプLMV7512さらに発展する CMOS OPアンプたち2入力オフセット電圧を自己補正する CMOS OPアンプTLC4501/45022	20 220 221 223 224 226 228 29
8.1	章 CMOS型OPアンプICの解析22CMOS OPアンプの登場と高性能化2低消費電力化とレール・ツー・レール動作2CMOSレール・ツー・レールOPアンプAD85322低ひずみのOPアンプOPA340/350/2340/23502R-R入力特有のミッド・スイングひずみに注意2ミッド・スイングひずみを避ける方法2CMOSの低雑音OPアンプLMV7512さらに発展する CMOS OPアンプたち2入力オフセット電圧を自己補正する CMOS OPアンプTLC4501/45022オフセット電圧打ち消しのメカニズム2	20 220 221 223 224 226 228 29 229 230
8.1	章 CMOS型OPアンプICの解析22CMOS OPアンプの登場と高性能化2低消費電力化とレール・ツー・レール動作2CMOSレール・ツー・レールOPアンプAD85322低ひずみのOPアンプOPA340/350/2340/23502R-R 入力特有のミッド・スイングひずみに注意2ミッド・スイングひずみを避ける方法2CMOSの低雑音OPアンプLMV7512さらに発展するCMOS OPアンプたち2入力オフセット電圧を自己補正するCMOS OPアンプTLC4501/45022オフセット電圧打ち消しのメカニズム2TLC4501を用いた高精度電圧源2	20 220 221 223 224 226 228 29 229 230 232
8.1	章 CMOS型OPアンプICの解析22CMOS OPアンプの登場と高性能化22低消費電力化とレール・ツー・レール動作2CMOSレール・ツー・レールOPアンプAD85322低ひずみのOPアンプOPA340/350/2340/23502R-R 入力特有のミッド・スイングひずみに注意2ミッド・スイングひずみを避ける方法2CMOSの低雑音 OPアンプLMV7512さらに発展する CMOS OPアンプたち2入力オフセット電圧を自己補正する CMOS OPアンプTLC4501/45022オフセット電圧打ち消しのメカニズム2TLC4501を用いた高精度電圧源22 V以下で動作する CMOS OPアンプNJU70962	20 220 221 223 224 226 228 229 230 232 233
8.1	章 CMOS型OPアンプICの解析22CMOS OPアンプの登場と高性能化2低消費電力化とレール・ツー・レール動作2CMOSレール・ツー・レールOPアンプAD85322低ひずみのOPアンプOPA340/350/2340/23502R-R入力特有のミッド・スイングひずみに注意2ミッド・スイングひずみを避ける方法2CMOSの低雑音OPアンプLMV7512さらに発展するCMOS OPアンプたち2入力オフセット電圧を自己補正するCMOS OPアンプたち2オフセット電圧打ち消しのメカニズム2TLC4501を用いた高精度電圧源22 V以下で動作するCMOS OPアンプNJU70962低電源電圧で安定に発振する正弦波発振器への応用2	20 220 221 223 224 226 228 229 230 232 233
8.1	章 CMOS型OPアンプICの解析22CMOS OPアンプの登場と高性能化22低消費電力化とレール・ツー・レール動作2CMOSレール・ツー・レールOPアンプAD85322低ひずみのOPアンプOPA340/350/2340/23502R-R 入力特有のミッド・スイングひずみに注意2ミッド・スイングひずみを避ける方法2CMOSの低雑音 OPアンプLMV7512さらに発展する CMOS OPアンプたち2入力オフセット電圧を自己補正する CMOS OPアンプTLC4501/45022オフセット電圧打ち消しのメカニズム2TLC4501を用いた高精度電圧源22 V以下で動作する CMOS OPアンプNJU70962	20 220 221 223 224 226 228 29 230 232 233 233

第 1 章 OP アンプを 手作りトランジスタ回路で学ぶ

はじめに個別のトランジスタ5石で簡単なOPアンプを作ります。そのOPアンプで基本的な特性を測定しながら、OPアンプの用語と動作を学びましょう。

1.1 OPアンプのあらまし

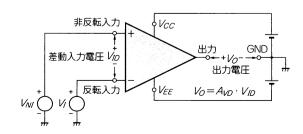
● OPアンプのもつ基本端子は五つ

図1-1をご覧ください、OPアンプには必ず以下の5個の端子があります。

- ・非反転入力端子(NonInverting Input)
- ・反転入力端子 (Inverting Input)
- ・正電源端子 $(V_{CC}, +V_{CC}, V^+, +V_S$ などと記す)
- ・負電源端子 $(V_{EE}, -V_{EE}, V^-, -V_S$ などと記す)
- ・出力端子 (Output)

このほかに「位相(周波数)補償端子」や「オフセット・ゼロ調整端子」などをもつことがあります。

〈図1-1〉 OPアンプの基本端子と 端子に加える電圧



● 二つの入力端子と一つの出力端子

- ▶ 反転入力と非反転入力
 - 二つの入力端子はOPアンプ記号の中に+と-を記し、つぎのように識別します。
 - +:非反転入力端子
 - -: 反転入力端子

二つの入力端子のどちらにも信号を加えることができます。OPアンプの非反転入力端子~グラウンド間電圧を「非反転入力電圧 V_{Nl} 」、反転入力端子~グラウンド間電圧を「反転入力電圧 V_{l} 」と呼びます。なお、以降はグラウンドをGNDと記します。

▶ 二つの入力電圧の差…差動入力電圧 V_{ID}

これは非反転入力端子と反転入力端子間の電圧です. すなわち,

 $V_{ID} = V_{NI} - V_I$ (1-1)

▶ シングル・エンド出力(Single End Output)

OPアンプの出力端子は一つで、出力端子~GND間電圧が出力電圧です。このように信号端子対の一端が接地されることを「シングル・エンド」といいます。

● OPアンプの増幅度···差動電圧利得 Avo

理想的なOPアンプの出力電圧 V_0 は、差動入力電圧 V_{ID} に比例します。その比例定数つまり増幅度を「差動電圧利得 A_{VD} 」といいます。すなわち、

 $V_{O} = A_{VD} \cdot V_{ID}$ (1-2)

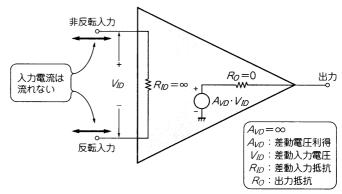
交流信号に対する差動電圧利得を「オープン・ループ・ゲイン(Open Loop Gain)」とか「開ループ・ゲイン」と呼びます。OPアンプのデータ・シートに記載されている電圧利得は一般に直流・差動電圧利得で、無限と言って良いほどの大きな利得が特徴です。

● OP アンプの電源電圧

OPアンプは基本的には2電源で使用します。正電源端子~GND間には+5~+15 V ぐらいの電圧を与え、負電源端子~GND間には-5~-15 V ぐらいの電圧を与えます。しかし、負電源端子を接地して1電源で使用する場合もあります(最近はとくに5 V 1 電源で使うケースが多くなってきている)。

なお図面上で回路をすっきり見せるために、OPアンプの電源端子や電源ラインをあえて回路図に記さないことがあります. もちろん実際には図1-1に示したように電源を接続しなければなりません.

〈図1-2〉 理想OPアンプ



● 設計するときに便利な理想 OP アンプの考え

図1-2に示す, つぎの条件を満足するOPアンプを「理想OPアンプ」といいます. 実際にはもちろん存在しませんが, 応用回路の設計や解析を行うときは理想モデルとして考えると簡単になります.

- ・入力オフセット電圧がゼロ.
- ・DC入力電流がゼロ
- ・入力抵抗が∞
- ・出力抵抗がゼロ
- ・差動電圧利得が∞
- ・無限の高速応答
- ・雑音を発生しない

理想に近いOPアンプが優れたOPアンプということになりますが、実際は用途によってそれぞれのパラメータが理想に近づいたものが使用されています。

1.2 5石OPアンプの実験

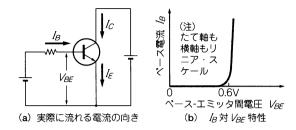
● OPアンプの中身…トランジスタによる増幅回路

OPアンプを製作する前に、簡単にトランジスタの動作を復習しておきましょう。図1-3をご覧ください。

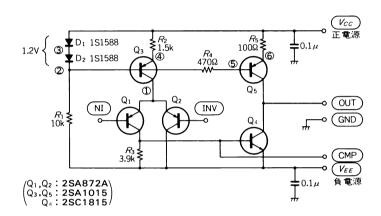
NPN型トランジスタのベース-エミッタ間に正の電圧を加え、コレクタ-エミッタ間に正の電圧を与えると、図(a)に示す向きに電流が流れます。そして、エミッタ電流 I_E 、コレクタ電流 I_C 、ベース電流 I_B の間には常に次式が成り立ちます。

$$I_E = I_C + I_B \cdots (1-3)$$

〈図1-3〉 NPN型トランジスタの端子電流と 端子電圧



〈図1-4〉 5石OPアンプの 回路構成



コレクタ電流はベース電流に比例します.

$$I_C = h_{FE}I_B \cdots (1-4)$$

このときの比例定数 h_{FF} を「直流電流増幅率」といいます。

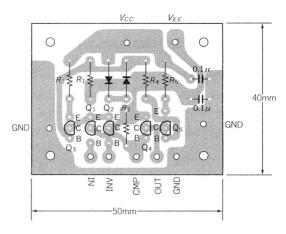
ベース-エミッタ間電圧 V_{BE} とベース電流 I_B の間には図(b)に示すような関係があります。 PNP型トランジスタは、NPN型トランジスタと電圧と電流の向きがすべて逆ですが、やはり式(1-3)と式(1-4)および図(b)に示す関係が成り立ちます。

● 5石OPアンプを製作する

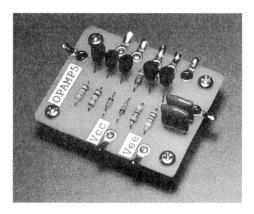
ここで製作するトランジスタによるOPアンプ回路を図1-4に示します。これは拙著「はじめてのトランジスタ回路設計」(CQ出版社刊)で設計した物です。本物のOPアンプICにはもっと多くのトランジスタが集積されていますが、ここでは動作を理解するのが目的なので、簡易型OPアンプとなっています。

NIが非反転入力端子、INVが反転入力端子です。電源端子~GND間の2個のコンデン

〈図1-5〉 5石OPアンプの部品配置とプリント・ パターン(銅箔面)



<写真1-1〉 製作した5石OPアンプの基板 (拙著「はじめてのトランジス タ回路設計」(CQ 出版社刊)で 詳しい設計例を紹介している)



サは高い周波数での電源インピーダンスを下げるためのもので、通称は「パスコン」。正式には「バイパス・コンデンサ」といいます。電源電圧が \pm 15 Vですから、耐圧が25 V 以上のセラミック・コンデンサかマイラ・コンデンサが適当です。

トランジスタ Q_4 のベースから引き出されたCMPは位相補償のためのコンデンサを付けるための端子です。CMP \sim OUT端子間にセラミックあるいはマイカ型コンデンサを位相補償用として接続します。

このOPアンプ回路のプリント基板パターンを図1-5に、完成基板を写真1-1に示します。製作はユニバーサル・プリント基板でも構いませんが、配線距離は短く、GNDラインはできるだけ太くします。

索引

【数 字】	1KF 138	1 1 2 2 2 4 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	LED123	エミッタ・フォロワの
1/f コーナ周波数174	Micro-Cap V/CQ版 ······65	小信号等価回路51
1/f 雑音174	NPN 型 BJT のダイオード接続 …167	エミッタ面積37
1 チップ・デュアル FET113	N チャネル接合型 FET115	オープン・ループ・ゲイン12
1 チップ・デュアル・トランジスタ …143	OP アンプの雑音等価回路180	オフセット・ゼロ調整回路81
3 dB カットオフ周波数20	R-R 出力 ······221	温度解析73
3 端子電圧リファレンス232	R-R 入出力 OP アンプ220	
	R-R 入力 ·······221	【カ 行】
【欧 文】	SAR230	カーボン皮膜抵抗143
AB級 ······47	SBD210	開ループ・ゲイン12
AC-DC コンバータ210	SPICE61	開ループ出力インピーダンス …158
AC 解析 ·······63	SPICE2G662	回路図エディタ63
	SPICE362	I .
A 級	1	回路図ファイル63
BF94	VA98	拡散
Bi-CMOS 型······147	VAF	拡散容量99
Bi-FET 型 ······147	V _{IE} の温度係数 ·······48	角周波数20
Bi-FET 技術 ······148	VCCS50	過剰少数キャリア158
BR95	VIP プロセス195	カスコード回路113, 116
B級······47	V_P ······116	カスコード・
CB プロセス198	XTB73, 74	ブートストラップ123, 170
CCCS50	уパラメータ49	活性領域93
CJC99	β_F 94	カットオフ周波数20
CJE99	β_R 95	過渡解析63
CMOS 型 ······147	π型モデル ······116	カレント・ミラー36, 37, 222
CMOS 型 OP アンプ220	I 4m3	カレント・ミラー負荷・
	【アー行】	
CMU87		差動増幅回路42, 50
CMU	アーリ効果98	差動増幅回路 ·······42, 50 帰還率β ·····18
CMU	アーリ効果98 アーリ電圧98	差動増幅回路 ······42, 50 帰還率 β ·····18 帰還量 ····19
${f CMU}$ 87 ${\cal C}_{ob}$ キャンセル回路127, 131 ${f CPI}$ 85 ${\cal C}_{\mu}$ 87	アーリ効果98 アーリ電圧98 アイドリング電流46	差動増幅回路
${f CMU}$ 87 ${C_{ob}}$ キャンセル回路 127, 131 CPI 85 ${C_{\mu}}$ 87 ${C_{\pi}}$ 87 ${C_{\pi}}$ 87 85	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39	差動増幅回路 42.50 帰選率 β 18 帰選量 19 逆接続領域 94 局部電流帰還 195
${ m CMU}$ 87 ${C_{ob}}$ キャンセル回路 127, 131 ${ m CPI}$ 85 ${C_{\mu}}$ 87 ${C_{\pi}}$ 85 DC解析 63	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39 アンサンブル平均 176	差動増幅回路 42.50 帰還率 β 18 帰還量 19 逆接続領域 94 局部電流帰還 195 許容・差動入力電圧 210
${ m CMU}$ 87 ${C_{ob}}$ キャンセル回路 127, 131 ${ m CPI}$ 85 ${C_{\mu}}$ 87 ${C_{\pi}}$ 87 ${C_{\pi}}$ 87 ${C_{\pi}}$ 85 ${ m DC}$ 解析 63 ${ m DC}$ サーボ回路 174	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39 アンサンブル平均 176 イオン打ち込み 148	差動増幅回路 42.50 帰還率β 18 帰還量 19 逆接続領域 94 局部電流帰還 195 許容・差動入力電圧 210 金属皮膜抵抗 143
${ m CMU}$ 87 ${C_{ob}}$ キャンセル回路 127, 131 ${ m CPI}$ 85 ${C_{\mu}}$ 87 ${C_{\pi}}$ 85 ${C_{\mu}}$ 87 ${C_{\pi}}$ 85 ${DC}$ 解析 63 ${DC}$ サーボ回路 174 ${DFT}$ 145	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39 アンサンブル平均 176 イオン打ち込み 148 異極性ダーリントン・	差動増幅回路 42.50 帰還率 β 18 帰還量 99 逆接続領域 94 局部電流帰還 195 許容・差動入力電圧 210 金属皮膜抵抗 143
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39 アンサンブル平均 176 イオン打ち込み 148 異権性ダーリントン・ エミッタ・フォロワ 98	差動増幅回路 42.50 帰還率 β 18 帰還量 19 逆接続領域 94 局部電流帰還 195 許容・差動入力電圧 210 金属皮膜抵抗 143 クローズド・ループ・カットオフ周波数 38
CMU 87 C_{ob} キャンセル回路 127, 131 CPI 85 C_{μ} 87 C_{π} 87 C_{π} 87 C_{π} 87 C_{π} 87 DC 解析 63 DC サーボ回路 174 DFT 145 DG 200 Difet プロセス 212	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39 アンサンブル平均 176 イオン打ち込み 148 異様性ダーリントン・ エミッタ・フォロワ 198 位相 29	差動増幅回路 42.50 帰還率 β 18 帰還量 19 逆接続領域 94 局部電流帰還 195 許容・差動入力電圧 210 金属皮膜抵抗 143 クローズド・ループ・ カットオフ周波数 33
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39 アンサンブル平均 176 イオン打ち込み 148 異極性ダーリントン・ エミッタ・フォロワ 198 位相 29 位相・周波数特性 30	差動増幅回路 42.50 帰還率 β 18 帰還量 19 逆接続領域 94 局部電流帰還 195 許容・差動入力電圧 210 金属皮膜抵抗 143 クローズド・ループ・ カットオフ周波数 33 クローズド・ループ・ゲイン 19 ゲート・リーク電流 120
${ m CMU}$ 87 ${C_o}$ キャンセル回路 127, 131 ${ m CPI}$ 85 ${C_\mu}$ 87 ${C_\nu}$ 87 ${C_\nu}$ 87 ${C_\nu}$ 87 ${C_\tau}$ 85 DC 解析 63 DC サーボ回路 174 DFT 145 ${DG}$ 200 Difet プロセス 212 ${DP}$ 200 FET 人力型 147	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39 アンサンブル平均 176 イオン打ち込み 148 異極性ダーリントン・ エミッタ・フォロワ 198 位相 29 位相・周波数特性 30 位相特性 30	差動増幅回路 42.50 帰還率 β 18 帰還量 19 逆接続領域 195 許容・差動入力電圧 210 金属皮膜抵抗 143 クローズド・ループ・カットオフ周波数 33 クローズド・ループ・ゲイン 19 デート・リーク電流 120 高域ロールオフ 30
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39 アンサンブル平均 176 イオン打ち込み 148 異極性ダーリントン・エミッタ・フォロワ 198 位相 29 位相・周波数特性 30 位相特性 30 位相補償 15	差動増幅回路 42.50 帰還率β 18 帰還量 19 逆接続領域 94 局部電流帰還 195 許容・差動入力電圧 210 金属皮膜抵抗 143 クローズド・ループ・カットオフ周波数 33 クローズド・ループ・ゲイン 119 ゲート・リーク電流 120 高域ロールオフ 30 高精度 OP アンプ 169
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39 アンサンブル平均 176 イオン打ち込み 148 異極性ダーリントン・エミッタ・フォロワ 198 位相 29 位相・間波数特性 30 位相特性 30 位相特性 30 位相補償 15	差動増幅回路 42.50 帰還率β 18 帰還量 19 逆接続領域 94 局部電流帰還 195 許容・差動入力電圧 210 金属皮膜抵抗 143 クローズド・ループ・カットオフ周波数 33 クローズド・ループ・ゲイン 19 ゲート・リーク電流 120 高域ロールオフ 30 高精度 OP アンプ 169 高速 PNPトランジスタ 193
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39 アンサンブル平均 176 イオン打ち込み 148 異権性ダーリントン エミッタ・フォロワ 198 位相 29 位相・周波数特性 30 位相補償 15 位相補償を量 20 位相補償 15 位相補償 33 位相余裕 33	差動増幅回路 42.50 帰還率 β 18 帰還量 19 逆接続領域 94 局部電流帰還 195 許容・差動入力電圧 210 金属皮膜抵抗 143 クローズド・ループ・ カットオフ周波数 33 クローズド・ループ・ゲイン 19 ゲート・リーク電流 120 高域ロールオフ 30 高域 193 高速 PNPトランジスタ 193 高速型 193
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39 アンサンブル平均 176 イオン打ち込み 148 異極性ダーリントン エミッタ・フォロワ 198 位相 29 位相・周波数特性 30 位相特性 30 位相補償 51 位相補償容量 20,55,203,206 位相余裕 33,54 ウィルソン型カレント・ミラー 154	差動増幅回路 42.50 帰還率 β 18 帰還量 19 逆接続領域 94 局部電流帰還 195 許容・差動入力電圧 210 金属皮膜抵抗 143 クローズド・ループ・ カットオフ周波数 33 クローズド・ループ・ゲイン 19 ゲート・リーク電流 120 高域ロールオフ 30 高速型 193 広帯域型 193
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39 アンサンブル平均 176 イオン打ち込み 148 異極性ダーリントン エミッタ・フォロワ 198 位相 29 位相・周波数特性 30 位相特性 30 位相補償容量 20,55,203,206 位相余裕 33,54 ウィルソン型カレント・ミラー 154 エバース・モル・モデル 98	差動増幅回路 42.50 帰還率 β 18 帰還量 19 逆接続領域 94 治審電流帰還 195 許容・差動入力電圧 210 金属皮膜抵抗 143 クローズド・ループ・カットオフ周波数 33 クローズド・ループ・ゲイン 19 ゲート・リーク電流 120 高域ロールオフ 30 高精度 OP アンプ 169 高速型 193 広帯域型 193 エアックタ接地回路 44
${ m CMU}$ 87 ${ m }{C_{ob}}$ キャンセル回路 127, 131 ${ m CPI}$ 85 ${ m }{C_{\mu}}$ 87 ${ m }{C_{\mu}}$ 87 ${ m }{C_{\pi}}$ 87 ${ m }{C_{\pi}}$ 85 ${ m }{ m }$	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39 アンサンブル平均 176 イオン打シみ 148 異極性ダーリントン 198 位相 29 位相・周波数特性 30 位相特性 30 位相補償 15 位相補償 20, 55, 203, 206 位相余裕 33, 54 ウィルソン型カレント・ミラー 154 エバース・モル・モデル 92 エミッタ接地・	差動増幅回路 42.50 帰還率 β 18 帰還量 19 逆接続領域 94 治療電流帰還 195 許容・差動入力電圧 210 金属皮膜抵抗 143 クローズド・ループ・ケイン 19 グート・リーク電流 120 高域ロールオフ 30 高精度 OP アンプ 169 高速型 193 広帯域型 193 広帯域型 193 広帯域型 193 エアレクタ接地回路 44 コンパレータ 233
${ m CMU}$ 87 ${ m }{C_{ob}}$ キャンセル回路 127, 131 ${ m CPI}$ 85 ${ m }{C_{\mu}}$ 87 ${ m }{C_{\pi}}$ 85 ${ m }{DC}$ 87 ${ m }{MF}$ 63 ${ m DC}$ 97 145 ${ m }{DFT}$ 145 ${ m }{DG}$ 200 ${ m Difet}$ プロセス 212 ${ m }{DFT}$ 200 ${ m FET}$ 入力型 147 ${ m FET}$ の出力静特性 115 ${ m FET}$ の出力静特性 116 ${ m }{GBP}$ 56 ${ m }{GB}$ 31 ${ m }{gs}$ 97 ${ m }{h_{pr}}$ 49 ${ m }{h_{pr}}$ 49 ${ m }{h_{pr}}$ 49	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39 アンサンブル平均 176 イオン打ち込み 148 異極性ダーリントン エミッタ・フォロワ 198 位相 周波数特性 30 位相・間波数特性 30 位相補償 15 位相補償な量 25, 203, 206 位相余裕 33, 54 ウイルソン型カレント・ミラー 154 エバース・モル・モデル 92 エミッタ接地・ 逆方向電流増幅率 95	差動増幅回路 42.50 帰還率β 18 帰還量 19 逆接続領域 94 局部電流帰還 195 許容・差動入力電圧 210 金属皮膜抵抗 143 クローズド・ループ・カットオフ周波数 33 クローズド・ループ・ゲイン 19 ゲート・リーク電流 120 高域ロールオフ 30 高精度 OP アンプ 169 高速型 193 広帯域型 193 広帯域型 193 広帯域型 193 エルクタ接地回路 44 コンパレータ 233 コンプリメンタリ・
${ m CMU}$ 87 ${ m }{C_{ob}}$ キャンセル回路 127, 131 ${ m CPI}$ 85 ${ m }{C_{\mu}}$ 87 ${ m }{C_{\pi}}$ 85 ${ m }{DC}$ 85 ${ m }{DC}$ 87 ${ m }{MF}$ 63 ${ m }{DC}$ 97 ${ m }{DFT}$ 145 ${ m }{DG}$ 200 ${ m }{DIST}$ 147 ${ m }{DFT}$ 212 ${ m }{DP}$ 200 ${ m }{FET}$ 147 ${ m }{PET}$ 147 ${ m }{FET}$ 0出力静特性 115 ${ m }{FET}$ の他和領域 116 ${ m }{GBP}$ 56 ${ m }{GB}$ 31 ${ m }{g}$ ${ m }{g}$ 97 ${ m }{h_{pc}}$ 49 ${ m }{h_{pc}}$ 49 ${ m }{h_{pc}}$ 49	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39 アンサンブル平均 176 イオンブも入み 148 異権性ダーリントン・エミッタ・フォロワ 198 位相 29 位相・周波数特性 30 位相特性 30 位相補償 15 位相補償を量 20, 55, 203, 206 位相余裕 33, 54 ウィルソン型カレント・ミラー 154 エバース を地・ 逆方向電流増幅率 95 エミッタ接地・	差動増幅回路 42.50 帰還率 β 18 帰還量 19 逆接続領域 94 治療電流帰還 195 許容・差動入力電圧 210 金属皮膜抵抗 143 クローズド・ループ・ケイン 19 グート・リーク電流 120 高域ロールオフ 30 高精度 OP アンプ 169 高速型 193 広帯域型 193 広帯域型 193 広帯域型 193 エアレクタ接地回路 44 コンパレータ 233
CMU 87 Cos キャンセル回路 127, 131 CPI 85 Cμ 87 Cκ 85 DC 解析 63 DC サーボ回路 174 DFT 145 DG 200 Difet プロセス 212 DP 200 FET 入力型 147 FET の他力静特性 115 FET の他和領域 116 GBP 56 GB積 31 8 κ 97 h/c 49 h/c 49 h/c 49 h/c 1/5 メータ 49 I C V BC 特性曲線 47	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39 アンサンブル平均 176 イオン打ち込み 148 異極性ダーリントン・エミッタ・フォロワ 198 位相・周波数特性 30 位相特性 30 位相補償を量 20, 55, 203, 206 位相余裕 33, 54 ウィルソン型カレント・ミラー 154 エバースを地・ 逆方り配電流増幅率 95 エミッタ接地・ 順方向電流増幅率 94	差動増幅回路 42.50 帰還率β 18 帰還量 19 逆接続領域 94 治療電流帰還 195 許容・差動入力電圧 210 金属皮膜抵抗 143 クローズド・ループ・ケイン 19 グート・リーク電流 120 高域ロールオフ 30 高精度 OP アンプ 169 高速型 193 広帯攻型 193 広帯攻型 193 広帯攻型 193 広帯攻型 193 広帯なり 194 コンパレータ 233 コンプリメンタリ・エミッタ・フォロワ 44
${ m CMU}$ 87 ${ m }{C_o}$ キャンセル回路 127, 131 ${ m CPI}$ 85 ${ m }{C_s}$ 87 ${ m }{C_s}$ 87 ${ m }{C_s}$ 87 ${ m }{C_s}$ 85 ${ m DC}$ 解析 63 ${ m DC}$ 97 145 ${ m DFT}$ 145 ${ m DG}$ 200 ${ m Difet}$ プロセス 212 ${ m DP}$ 200 ${ m FET}$ 九型 147 ${ m FET}$ の出力静特性 115 ${ m FET}$ の出力静特性 115 ${ m FET}$ の的和領域 116 ${ m GBP}$ 56 ${ m GBR}$ 31 ${ m }{8}$ ${ m }{s}$ 97 ${ m }{h_{lc}}$ 49 ${ m }{h_{lc}}$ 47 ${ m }{I_c}$ ${ m }{V_{BE}}$ 特性曲線 47 ${ m }{I_c}$ ${ m }{V_{BE}}$ 特性曲線 97	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39 アンサンブル平均 176 イオン打ち込み 148 異様性ダーリントン・エミッタ・フォロワ 198 位相・ 29 位相・ 30 位相特性 30 位相特性 30 位相補償 51 位相補償 52 立相・高波数特性 33 位相未務 33.54 ウィルソン型カレント・ミラー 154 エバース・モル・モデル 92 エミック接電・ 95 エ順方向電池・ 95 エ順方向電池・ 94 エミック接地・ 94	差動増幅回路 42.50 帰還率 β 18 帰還量 19 逆接続領域 195 許容・差動入力電圧 210 金属皮膜抵抗 143 クローズド・ループ・ カットオフ周波数 33 クローズド・ループ・ゲイン 19 ゲート・リーク電流 120 高域ロールオフ 30 高精度 OP アンプ 169 高速 PNPトランジスタ 193 高速型 193 エレクタ接地回路 193 エレクタ接地回路 193 エレクタ接地回路 233 コンパレータ 233 コンプリメンタリ・ エミッタ・フォロワ 44 【サ 行】
CMU 87 Cos キャンセル回路 127, 131 CPI 85 Cμ 87 Cκ 85 DC 解析 63 DC サーボ回路 174 DFT 145 DG 200 Difet プロセス 212 DP 200 FET 入力型 147 FET の他力静特性 115 FET の他和領域 116 GBP 56 GB積 31 8 κ 97 h/c 49 h/c 49 h/c 49 h/c 1/5 メータ 49 I C V BC 特性曲線 47	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39 アンサンブル平均 176 イオン打ち込み 148 異性ダーリントン エミッタ・フォロワ 198 位相 29 位相・周波数特性 30 位相特性 30 位相補償容量 20, 55, 203, 206 位相未確常 33, 54 ウイルソン型カレント・ミラー 154 エバース・モル・モデル 92 エミッタ接地・ 遊方向電流増幅率 順方向電流増幅率 94 エミッタ接地・ 小信号電流増幅率 小信号電流増幅率 109	差動増幅回路 42.50 帰還率β 18 帰還量 19 逆接続領域 94 治療電流帰還 195 許容・差動入力電圧 210 金属皮膜抵抗 143 クローズド・ループ・ケイン 19 グート・リーク電流 120 高域ロールオフ 30 高精度 OP アンプ 169 高速型 193 広帯攻型 193 広帯攻型 193 広帯攻型 193 広帯攻型 193 広帯なり 194 コンパレータ 233 コンプリメンタリ・エミッタ・フォロワ 44
${ m CMU}$ 87 ${ m }{C_o}$ キャンセル回路 127, 131 ${ m CPI}$ 85 ${ m }{C_s}$ 87 ${ m }{C_s}$ 87 ${ m }{C_s}$ 87 ${ m }{C_s}$ 85 ${ m DC}$ 解析 63 ${ m DC}$ 97 145 ${ m DFT}$ 145 ${ m DG}$ 200 ${ m Difet}$ プロセス 212 ${ m DP}$ 200 ${ m FET}$ 九型 147 ${ m FET}$ の出力静特性 115 ${ m FET}$ の出力静特性 115 ${ m FET}$ の的和領域 116 ${ m GBP}$ 56 ${ m GBR}$ 31 ${ m }{8}$ ${ m }{s}$ 97 ${ m }{h_{lc}}$ 49 ${ m }{h_{lc}}$ 47 ${ m }{I_c}$ ${ m }{V_{BE}}$ 特性曲線 47 ${ m }{I_c}$ ${ m }{V_{BE}}$ 特性曲線 97	アーリ効果 98 アーリ電圧 98 アイドリング電流 46 アクティブ・ロード 39 アンサンブル平均 176 イオン打ち込み 148 異様性ダーリントン・エミッタ・フォロワ 198 位相・ 29 位相・ 30 位相特性 30 位相特性 30 位相補償 51 位相補償 52 立相・高波数特性 33 位相未務 33.54 ウィルソン型カレント・ミラー 154 エバース・モル・モデル 92 エミック接電・ 95 エ順方向電池・ 95 エ順方向電池・ 94 エミック接地・ 94	差動増幅回路 42.50 帰還率 β 18 帰還量 19 逆接続領域 195 許容・差動入力電圧 210 金属皮膜抵抗 143 クローズド・ループ・ カットオフ周波数 33 クローズド・ループ・ゲイン 19 ゲート・リーク電流 120 高域ロールオフ 30 高精度 OP アンプ 169 高速 PNPトランジスタ 193 高速型 193 エレクタ接地回路 193 エレクタ接地回路 193 エレクタ接地回路 233 コンパレータ 233 コンプリメンタリ・ エミッタ・フォロワ 44 【サ 行】

雑音波の大きさ176	伝達抵抗205	副作用196
差動出力ライン・ドライバ227	伝達容量205	フル・パワー応答周波数24
差動増幅回路17, 39	電流帰還型 OP アンプ202, 203	ブレークダウン防止用
差動増幅回路の雑音等価回路 …180	電流制御・電流源50	ダイオード138
差動電圧利得 A _{vp} ······12	電流制限抵抗161, 222	平衡増幅器216
差動入力電圧12	等価入力容量87	閉ループ・ゲイン19
差動利得217, 218	動作階級46	閉ループ出力インピーダンス …158
サブストレート(Substrate)	動作点76	ベース-エミッタ間抵抗49, 73
PNP トランジスタ167	同相出力電圧217	ベース接地回路105
サレン・キー・ローパス・	同相信号除去比218	ベース接地回路の出力抵抗 🛺 …108
フィルタ235	同相入力電圧28, 217	ベース接地・逆方向電流増幅率 …93
三極管領域116	同相負帰還218	ベース接地・出力抵抗 r _{ab} 106
時間平均176	同相利得217, 218	ベース接地出力容量 Cop105
二乗平均值176	トランジション周波数 f _T ······100	ベース接地(順方向)
実行ベース96	トランジット時間 τε111	電流増幅率 α _F ······17
従属電流源50	トランス・インピーダンス205	ベース接地・
周波数応答法29		順方向電流増幅率93
周波数特性30	【ナー行】	ベース接地・
出力コンダクタンス g _o ·······72, 98	入力オフセット電圧26, 172	小信号電流増幅率 hp ······109
出力段のひずみ打ち消し回路 …190	入力オフセット電流26	ベース接地・
出力抵抗 r。72, 98	入力換算雑音電圧178	小信号等価回路105
出力電流制限回路157	入力換算雑音電圧密度181	ベース幅97
順方向遷移時間99	入力雑音電流密度182	ベース広がり抵抗96
小信号電流増幅率43, 49	入力バイアス電流26	別名(Alias) ······67
小信号等価回路48	入力バイアス電流打ち消し回路 170	方形波25
少数キャリアの移動97	熱結合80	飽和電流37, 76, 94
ショット雑音178	熱雑音177	飽和防止回路81, 158
シングルエンド12, 217	熱雑音電圧密度177	飽和領域95, 116
振幅・周波数特性30	熱電圧43	ボーデ線図30, 54
スルーレート …24, 55, 56, 118, 136	ネット・リスト63	ボーデの安定判別法32
正弦波発振器233	ノイズ・ゲイン185, 198	ボルテージ・フォロワ21
接合容量98	濃度勾配97	ホワイト・ノイズ177
セトリング時間215	ノード(節点)番号65	I → ≤1
遷移時間99	Lo 3=1	[マ 行]
線形領域116	[ハ 行]	ミッド・スイングひずみ224
全帰還21	ハイブリッドπ型モデル49, 96	ミラー効果86
全入力雑音電圧密度183	バイポーラ型147	モデル・パラメータ63
相互コンダクタンス g,, …43, 96, 116	バイポーラ入力型147	モデル・ライブラリ65
相補エミッタ接地203	パスコン15	ا=، مدا
相補ソース接地222	反転増幅器22	【ヤ 行】
相補ベース接地203	反転入力端子11	ユニティ・ゲイン周波数 f ₇ ······52, 165
素子モデル63	反転入力電圧12	I = 4=1
[点 行]	汎用 OP アンプ147	【ラ 行】
【夕 行】	非反転增幅器18	ラテラル PNP トランジスタ …162
ダーリントン接続43	非反転入力端子11	利得交点周波数33
第3次高調波ひずみ率126	非反転入力電圧12	利得帯域幅積31, 56, 165
ダイナミック・レンジ220	微分位相誤差200	ループ・ゲイン19
直流電流増幅率14, 43	微分利得誤差200	レール・ツー・レール (Rail-to-Rail)
チョッパ型229	ピンチオフ電圧116	入出力 OP アンプ220
ツェナ・ザップ・トリミング …172	フィード・フォワード	ローパス・フィルタ232
突き抜け111	(位相)補償164	【ワー行】
定電流回路16	ブートストラップ186, 199, 235	
電圧帰還型193	フォールデッド・カスコード	ワイドラー型
電圧制御・電流源50	问路113, 186, 195, 222	カレント・ミラー153
電源電圧変動除去比 SVRR89	不感带210	
伝達インピーダンス205	負帰還18	

〈著者略歷〉

黒田 徹(くろだ とおる)

1945年 兵庫県に生まれる

1970年 神戸大学 経済学部卒業

1971年 日本電音(株)入社,技術部勤務

1972 年 同社退社

現 在 黒田電子技術研究所 所長

〈主な著書〉

- ・はじめてのトランジスタ回路設計 (CQ出版社)
- ・基礎トランジスタ・アンプ設計法 (ラジオ技術社)
- ・最新トランジスタ・アンプ設計法(ラジオ技術社)
- ●本書記載の社名,製品名について 本書に記載されている社名および製品名は,一般に開発メーカーの登録商標です。なお、本文中では ™、®、©の各表示を明記していません。
- ●本書掲載記事の利用についてのご注意 本書掲載記事は著作権法により保護され、また工業所有権が確立されている場合があります。したがって、記事として掲載された技術情報をもとに製品化をするには、著作権者および工業所有権者の許可が必要です。また、掲載された技術情報を利用することにより発生した損害などに関して、CQ出版社および著作権者ならびに工業所有権者は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●本書に関するご質問について 文章,数式などの記述上の不明点についてのご質問は、必ず往復はがきか返信用封筒を同封した封書でお願いいたします。ご質問は著者に回送し直接回答していただきますので、多少時間がかかります。また、本書の記載範囲を越えるご質問には応じられませんので、ご了承ください。

R〈日本複写権センター委託出版物〉

本書の全部または一部を無断で複写複製(コピー)することは、著作権法上での例外を除き、禁じられています.本書からの複製を希望される場合は、日本複写権センター(TEL: 03-3401-2382)にご連絡ください.

解析 OP アンプ&トランジスタ活用

2002年9月15日 初版発行 2005年2月1日 第2版発行

2010年12月1日 ディジタル/CD-R版rev.1

© 黒田 徹 2002 (無断転載を禁じます)

 著者
 黒田

 微

 発行人
 増田久喜

発行所 CQ 出版株式会社

〒 170-8461 東京都豊島区巣鴨 1-14-2

☎ 03-5395-2123 (出版部)

☎ 03-5395-2141(販売部)

振替 00100-7-10665

(定価はカバーに表示してあります)

乱丁. 落丁本はお取りかえします

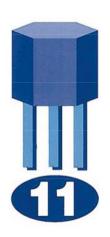
DTP·印刷·製本 三晃印刷㈱ Printed in Japan 解析 OPアンプ&トランジスタ活用 ディジタル/CD-R版

SD32691

価格:本体1,714円(税別)

価格:1,800円(税込)5%

CQ出版社



OPアンプの内部回路を解析・理解すると、貴方のアナログ回路設計力を飛 躍的に向上させることができます。

本書では、これまであまり詳しく語られることのなかった市販OPアンプIC の内部回路に焦点をあてて、如何にして増幅度を稼いでいるのか、なぜ高精度になっているのか、どのようにして低雑音を実現しているのか、どのようにして高速・広帯域化を実現しているのかなどを徹底検証しています。

また学習結果として、OPアンプICの性能を凌駕する個別トランジスタに よるアンプの設計技術を公開しています。回路シミュレータの回路設計への効 果的な利用方法も紹介しています。

読み進んでいくだけで、アナログ回路設計の楽しさを感じることのできる一 冊です。